

KS15

RELIABILITY DATA

信頼性データ

No. RD-08T-1449		
承認	査閲	担当
Kurosawa 31.Oct.'08	Y. Kihara 30.Oct.'08	M. Nagai 30.Oct.'08

INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF -----	R - 1
2. 部品ディレーティング Component Derating -----	R - 2
3. 主要部品温度上昇値 Temperature Rise ΔT -----	R - 5
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Elec. Capacitor Computed Life -----	R - 6
5. アブノーマル試験 Abnormal Test -----	R - 11
6. 振動試験 Vibration Test -----	R - 17
7. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test -----	R - 18
8. 静電気シミュレート試験 Electro-Static Discharge Test -----	R - 19
9. 雷サージ試験 Impulse Test -----	R - 20
10. 雑音端子電圧 Conducted Emission -----	R - 21

※信頼性データは、代表データであり、全ての製品は、ほぼ同等な特性を示します。
従いまして、この値は実力値とお考え願います。

The above data is typical value. As all units have nearly the same characteristics, the data to be considered as ability value.

1. MTBF 計算値 CALCULATED VALUES OF MTBF

MODEL : KS15

(1) 算出方法 Part count reliability projection

(社) 日本電子機械工業会 直流安定化電源(スイッチング方式)委員会の部品点数法で算出されています。

それぞれの部品ごとに、部品故障率 λ_G が与えられ、各々の点数によって決定されます。 λ_G は、MIL-HDBK-217Dに準じて定められています。

Calculated based on part count reliability projection by the Technical Committee on Stabilized Power Supplies of EIAJ.

Fixed failure rate λ_G is given to each individual part and MTBF is determined by the count of each part.

λ_G is determined based on MIL-HDBK-217D.

<算出式>

$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n N_i (\lambda_G)_i} \times 10^6 \text{ 時間 (Hours)}$$

λ_{equip} : 全機器故障率(故障数／ 10^6 時間)

Total Equipment Failure Rate (Failure／ 10^6 Hour)

λ_G : i番目の同属部品に対する故障率(故障数／ 10^6 時間)

Generic Failure Rate for The ith Generic Part

N_i : i番目の同属部品の個数

Quantity of ith Generic Part

n : 異なった同属部品のカテゴリーの数

Number of Different Generic Part Categories

(2) MTBF 値

$$MTBF = \frac{1 \times 10^6}{7.9443} = 125,876 \text{ 時間 (Hours)}$$

2. 部品ディレーティング COMPONENT DERATING

MODEL : KS15-5



(1) 算出方法 Calculating method

(a) 測定条件 Condition

・入力 : 100VAC ・出力 : 5V3A (100%)

Input Output

・周囲温度 : 50°C ・取付方法 : 標準取付(A)

Ambient temperature Mounting Method : Standard Mounting Method (A)

(b) 半導体 Semiconductors

周囲温度, 消費電力, 热抵抗より使用状態の接合点温度を求め最大定格, 接合点温度との比較を求めました。

Compared with maximum junction temperature and actual one which is calculated based on ambient temperature, power dissipation and thermal impedance.

(c) IC, 抵抗, コンデンサー等 IC, Resistors, Capacitors, etc.

周囲温度, 使用状態, 消費電力など, 個々の値は設計基準内に入っています。

Ambient temperature, operating condition, power dissipation and so on are within derating criteria.

(d) 热抵抗算出方法 Calculating method of thermal impedance

$$\theta_{j-c} = \frac{T_{j(max)} - T_c}{P_{c(max)}} \quad \theta_{j-a} = \frac{T_{j(max)} - T_a}{P_{c(max)}}$$

T_c : ディレーティングの始まるケース温度 一般に25°C

Case Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

T_a : ディレーティングの始まる周囲温度 一般に25°C

Ambient Temperature at Start Point of Derating ; 25°C in General

$P_{c(max)}$: 最大コレクタ損失

Maximum Collector Dissipation

$T_{j(max)}$: 最大接合点温度

Maximum Junction Temperature

θ_{j-c} : 接合点からケースまでの熱抵抗

Thermal Impedance between Junction and Case

θ_{j-a} : 接合点から周囲までの熱抵抗

Thermal Impedance between Junction and Air

		Vin=AC100V	LOAD=100%	Ta=50 °C
Q1 2SK1722FL TOSHIBA		Tchmax = 150 °C Θch-c = 2.08 °C/W Pd(max) = 60 W Pd = 0.97 W Δ Tc = 54.4 °C Tc = 104.4 °C Tch = Tc + (Θch-c) × Pd = 106.4 °C D.F. = 70.9%		
A1 M51977FP MITSUBISHI		Tjmax = 150 °C Θj-c = 21.4 °C/W Pd(max) = 1.5 W Pd = 0.37 W Δ Tc = 54.8 °C Tc = 104.8 °C Tj = Tc + (Θj-c) × Pd = 112.7 °C D.F. = 75.1%		
A2 HA17431FPA HITACHI		Tjmax = 150 °C Θj-c = 259 °C/W Pd(max) = 0.38 W Pd = 4.86 mW Δ Tc = 44.5 °C Tc = 94.5 °C Tj = Tc + (Θj-c) × Pd = 95.8 °C D.F. = 63.9%		
PC1 (LED) TLP121GR TOSHIBA		Tjmax = 125 °C Θj-c = - °C/W Pd(max) = - W If = 1.15 mA Δ Tc = 41.8 °C Tc = 91.8 °C ALLOWABLE If = 50 mA D.F. = 2.3%		
PC1 (TRANSISTOR) TLP121GR TOSHIBA		Tjmax = 125 °C Θj-c = 400 °C/W Pd(max) = 0.15 W Pd = 5.37 mW Δ Tc = 41.8 °C Tc = 91.8 °C Tj = Tc + (Θj-c) × Pd = 93.9 °C D.F. = 75.1%		
D1 S1ZB60 SHINDENGEN		Tjmax = 150 °C Θj-I = 20 °C/W Pd(max) = - W Pd = 0.203 W Δ TI = 51.8 °C TI = 101.8 °C Tj = TI + (Θj-I) × Pd = 105.9 °C D.F. = 70.6%		

TDK-Lambda

		Vin=AC100V	LOAD=100%	Ta=50°C
D2 D1FK40 SHINDENGEN		$T_{jmax} = 150 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\Theta_{j-l} = 23 \text{ } ^\circ\text{C/W}$ $P_d(\text{max}) = - \text{ W}$ $P_d = 3.26 \text{ mW}$ $\Delta T_l = 52.4 \text{ } ^\circ\text{C}$ $T_l = 102.4 \text{ } ^\circ\text{C}$ $T_j = T_l + (\Theta_{j-l}) \times P_d = 102.5 \text{ } ^\circ\text{C}$ D.F. = 68.3%		
D3 D1FL20U SHINDENGEN		$T_{jmax} = 150 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\Theta_{j-l} = 23 \text{ } ^\circ\text{C/W}$ $P_d(\text{max}) = - \text{ W}$ $P_d = 29.7 \text{ mW}$ $\Delta T_l = 52.6 \text{ } ^\circ\text{C}$ $T_l = 102.6 \text{ } ^\circ\text{C}$ $T_j = T_l + (\Theta_{j-l}) \times P_d = 103.3 \text{ } ^\circ\text{C}$ D.F. = 68.9%		
D4 TP802C04 FUJI ELECT		$T_{jmax} = 150 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\Theta_{j-l} = 3 \text{ } ^\circ\text{C/W}$ $P_d(\text{max}) = - \text{ W}$ $P_d = 0.825 \text{ W}$ $\Delta T_l = 59.1 \text{ } ^\circ\text{C}$ $T_l = 109.1 \text{ } ^\circ\text{C}$ $T_j = T_l + (\Theta_{j-l}) \times P_d = 111.6 \text{ } ^\circ\text{C}$ D.F. = 74.4%		
D5 TP802C04 FUJI ELECT		$T_{jmax} = 150 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\Theta_{j-l} = 3 \text{ } ^\circ\text{C/W}$ $P_d(\text{max}) = - \text{ W}$ $P_d = 0.825 \text{ W}$ $\Delta T_l = 61.2 \text{ } ^\circ\text{C}$ $T_l = 111.2 \text{ } ^\circ\text{C}$ $T_j = T_l + (\Theta_{j-l}) \times P_d = 113.7 \text{ } ^\circ\text{C}$ D.F. = 75.8%		
ZD1 MA1Z062 MATSUSHITA		$T_{jmax} = 150 \text{ } ^\circ\text{C}$ $\Theta_{j-l} = - \text{ } ^\circ\text{C/W}$ $P_d(\text{max}) = - \text{ W}$ $P_d = 0 \text{ W}$ $\Delta T_l = 48.2 \text{ } ^\circ\text{C}$ $T_l = 98.2 \text{ } ^\circ\text{C}$ $T_j = T_l + (\Theta_{j-l}) \times P_d = 98.2 \text{ } ^\circ\text{C}$ D.F. = 65.5%		

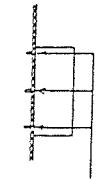
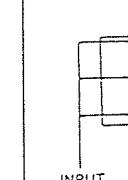
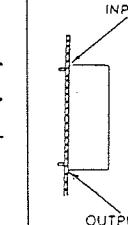
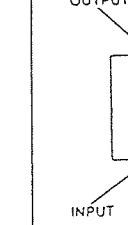
TDK-Lambda

ΔT TEMPERATURE RISE

MODEL : KS15

ΔT TEMPERATURE RISE (°C)						
OUTPUT DERATING(%) Ta:50°C	100	100	100	100	100	
LOCATION NO.	PARTS NAME	A	B	C	D	E
Q1	MOSFET	51.7	51.3	50.1	51.2	51.7
A1	PWM IC	54.2	55.7	52.7	53.7	53.6
D4	SBD	57.5	56.6	58.5	57.3	60.3
T1	T'MER	52.9	51.4	52.3	52.7	52.7
C4	E. CAP	41.1	42.2	39.4	40.4	41.3
C17	TANTALUM CAP	51.2	49.4	49.8	49.7	51.7

CONDITION : Ta:50 °C

MOUNTING METHOD (STANDARD MOUNTING : A)	A	B	C	D	E
					
INPUT VOLTAGE (Vac)	100	100	100	100	100
OUTPUT VOLTAGE (V)	5	5	5	5	5
OUTPUT CURRENT (A)	3	3	3	3	3
OUTPUT DERATING (%)	100	100	100	100	100

TDK-Lambda

PA759 - 66 - 02

ELECTROLYTIC CAPACITOR LIFETIME VERSUS LOAD

MODEL : KS15-5

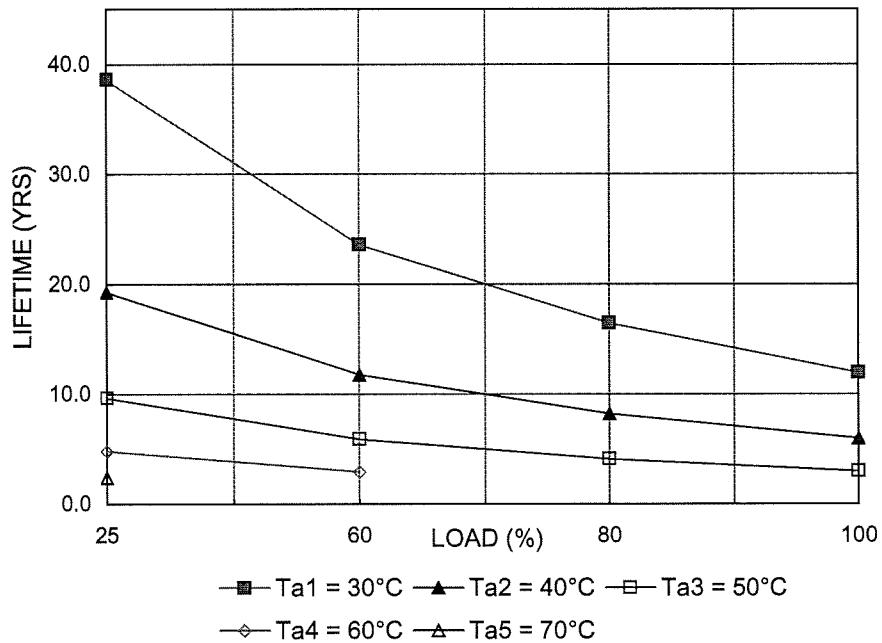
MOUNTING : A

VIN : 100VAC

DATE: SEPT 12, 2008

LOAD (%)	LIFETIME (YRS)				
	Ta = 30°C	Ta = 40°C	Ta = 50°C	Ta = 60°C	Ta = 70°C
25	38.6	19.3	9.7	4.8	2.4
60	23.6	11.8	5.9	3.0	
80	16.5	8.2	4.1		
100	12.0	6.0	3.0		

GRAPH OF ELECTROLYTIC CAPACITOR LIFETIME VS LOAD
MOUNTING A KS15-5



計算式 FORMULA

- | | | |
|--|--------|--|
| 1. アルミ電解コンデンサ
AL. Electrolytic capacitor
$L = Lo \times 2^{(105-Tc)/10}$ | L : | 電解コンデンサ推定寿命計算値
Elec. Capacitor computed life.
(24時間連続稼動、365日)
(24 hrs per day, 365 days per year) |
| 2. OSコンデンサ
O.S capacitor
$L = Lo \times 10^{(105-Tc)/22}$ | Lo : | 電解コンデンサ保証寿命値
Guarantee life for Elec. cap. |
| | Tc : | 電解コンデンサのケース温度
Case temperature of Elec. cap. |

TDK-Lambda

ELECTROLYTIC CAPACITOR LIFETIME VERSUS LOAD

MODEL : KS15-5

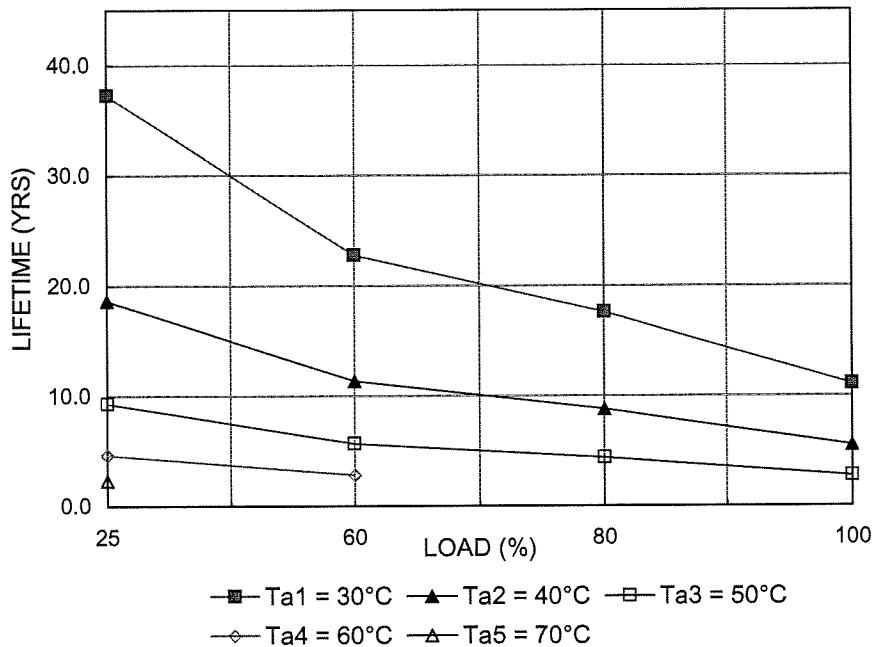
MOUNTING : B

VIN : 100VAC

DATE: SEPT 12, 2008

LOAD (%)	LIFETIME (YRS)				
	Ta = 30°C	Ta = 40°C	Ta = 50°C	Ta = 60°C	Ta = 70°C
25	37.3	18.6	9.3	4.7	2.3
60	22.8	11.4	5.7	2.9	
80	17.6	8.8	4.4		
100	11.1	5.5	2.8		

GRAPH OF ELECTROLYTIC CAPACITOR LIFETIME VS LOAD
MOUNTING B KS15-5



計算式 FORMULA

1. アルミ電解コンデンサ

AL. Electrolytic capacitor

$$L = Lo \times 2^{(105-T_c)/10} \quad (\text{year})$$

L : 電解コンデンサ推定寿命計算値

Elec. Capacitor computed life.

(24時間連続稼動、365日)

(24 hrs per day, 365 days per year)

2. OSコンデンサ

O.S capacitor

$$L = Lo \times 10^{(105-T_c)/22} \quad (\text{year})$$

Lo : 電解コンデンサ保証寿命値

Guarantee life for Elec. cap.

Tc : 電解コンデンサのケース温度

Case temperature of Elec. cap.

ELECTROLYTIC CAPACITOR LIFETIME VERSUS LOAD

MODEL : KS15-5

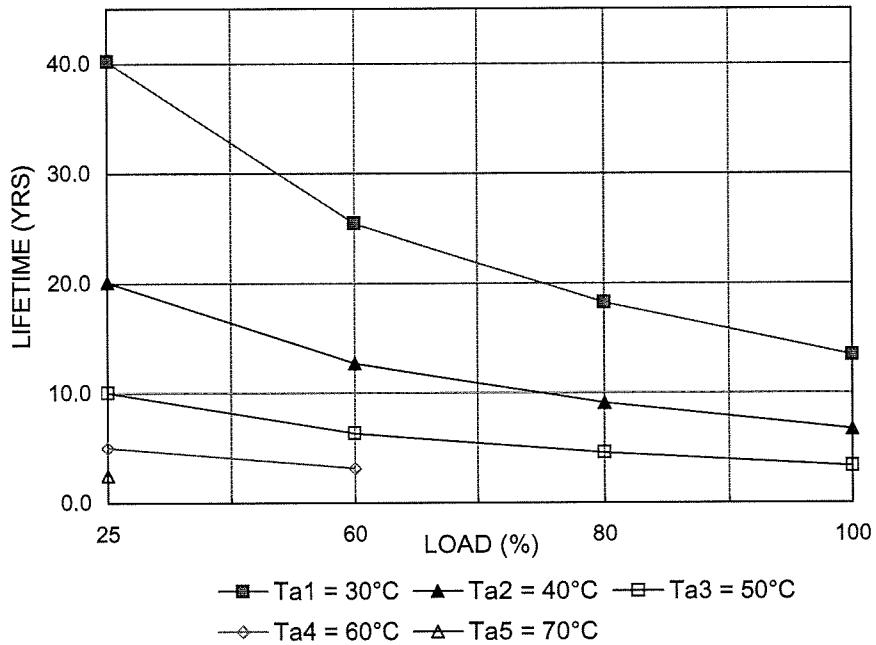
MOUNTING : C

VIN : 100VAC

DATE: SEPT 12, 2008

LOAD (%)	LIFETIME (YRS)				
	Ta = 30°C	Ta = 40°C	Ta = 50°C	Ta = 60°C	Ta = 70°C
25	40.3	20.1	10.1	5.0	2.5
60	25.5	12.7	6.4	3.2	
80	18.3	9.1	4.6		
100	13.5	6.7	3.4		

GRAPH OF ELECTROLYTIC CAPACITOR LIFETIME VS LOAD
MOUNTING C KS15-5



計算式 FORMULA

1. アルミ電解コンデンサ
AL. Electrolytic capacitor
 $L = Lo \times 2^{(105-Tc)/10}$ (year)

L : 電解コンデンサ推定寿命計算値
Elec. Capacitor computed life.
(24時間連続稼動、365日)
(24 hrs per day, 365 days per year)

2. OSコンデンサ
O.S capacitor
 $L = Lo \times 10^{(105-Tc)/22}$ (year)

Lo : 電解コンデンサ保証寿命値
Guarantee life for Elec. cap.
Tc : 電解コンデンサのケース温度
Case temperature of Elec. cap.

ELECTROLYTIC CAPACITOR LIFETIME VERSUS LOAD

MODEL : KS15-5

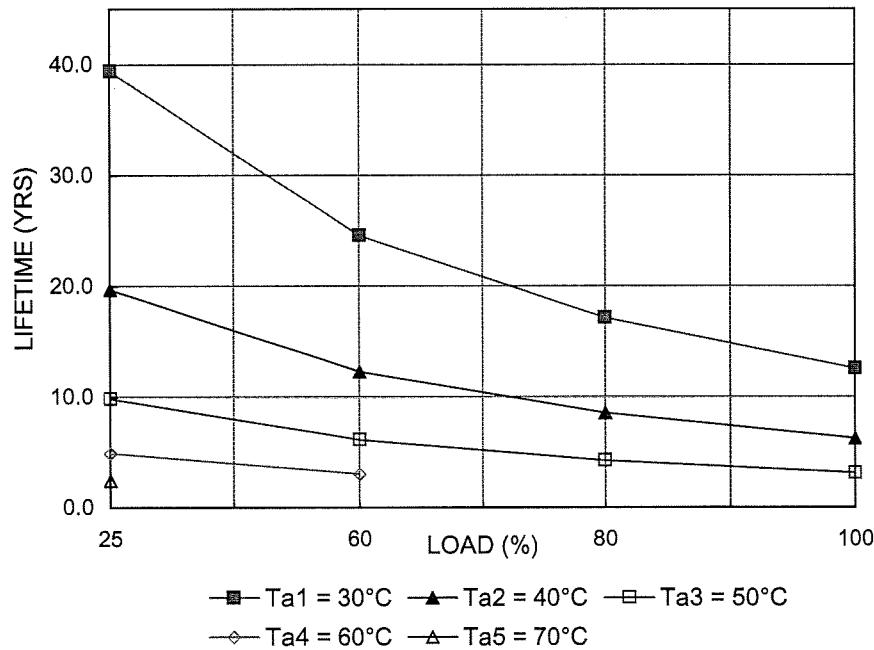
MOUNTING : D

VIN : 100VAC

DATE: SEPT 12, 2008

LOAD (%)	LIFETIME (YRS)				
	Ta = 30°C	Ta = 40°C	Ta = 50°C	Ta = 60°C	Ta = 70°C
25	39.4	19.7	9.9	4.9	2.5
60	24.6	12.3	6.2	3.1	
80	17.2	8.6	4.3		
100	12.6	6.3	3.1		

GRAPH OF ELECTROLYTIC CAPACITOR LIFETIME VS LOAD
MOUNTING D KS15-5



計算式 FORMULA

1. アルミ電解コンデンサ
AL. Electrolytic capacitor
 $L = Lo \times 2^{(105-Tc)/10}$ (year)

L : 電解コンデンサ推定寿命計算値
Elec. Capacitor computed life.
(24時間連続稼動、365日)
(24 hrs per day, 365 days per year)

2. OSコンデンサ
O.S capacitor
 $L = Lo \times 10^{(105-Tc)/22}$ (year)

Lo : 電解コンデンサ保証寿命値
Guarantee life for Elec. cap.
Tc : 電解コンデンサのケース温度
Case temperature of Elec. cap.

ELECTROLYTIC CAPACITOR LIFETIME VERSUS LOAD

MODEL: KS15-5

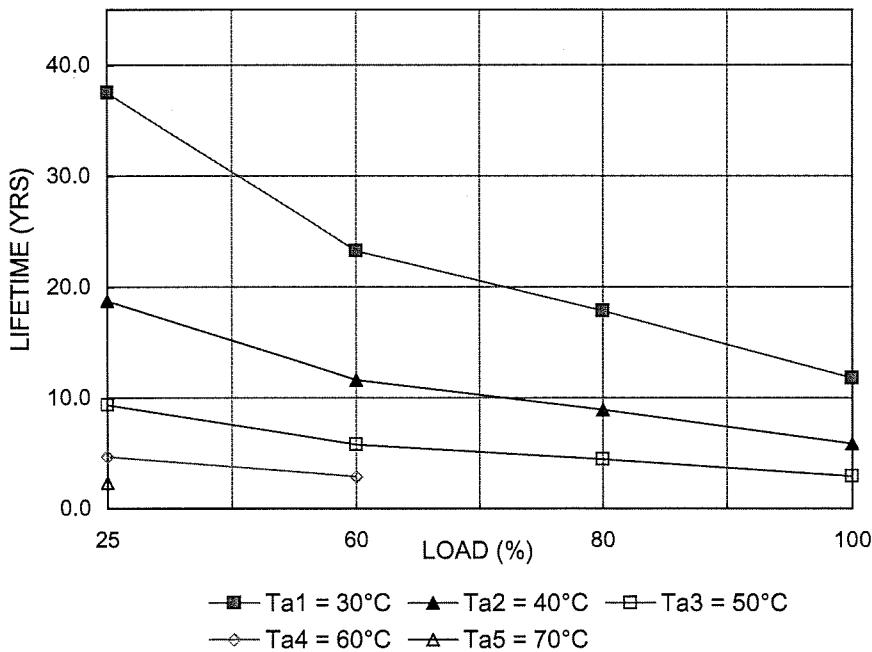
MOUNTING : E

VIN : 100VAC

DATE: SEPT 12, 2008

LOAD (%)	LIFETIME (YRS)				
	Ta = 30°C	Ta = 40°C	Ta = 50°C	Ta = 60°C	Ta = 70°C
25	37.6	18.8	9.4	4.7	2.3
60	23.3	11.6	5.8	2.9	
80	17.9	8.9	4.5		
100	11.8	5.9	3.0		

GRAPH OF ELECTROLYTIC CAPACITOR LIFETIME VS LOAD
MOUNTING E KS15-5



計算式 FORMULA

1. アルミ電解コンデンサ
AL. Electrolytic capacitor
 $L = Lo \times 2^{(105-Tc)/10}$

L : 電解コンデンサ推定寿命計算値
Elec. Capacitor computed life.
(24時間連続稼動、365日)
(24 hrs per day, 365 days per year)

2. OSコンデンサ
O.S capacitor
 $L = Lo \times 10^{(105-Tc)/22}$

Lo : 電解コンデンサ保証寿命値
Guarantee life for Elec. cap.
 Tc : 電解コンデンサのケース温度
Case temperature of Elec. cap.

TDK-Lambda

MODEL : KS15-5		ABNORMAL TESTING										TEST CONDITIONS		TESTED BY		
		LOAD = 100 %										Vin = 100VAC Ta = 25°C		DATE		
PARTS	NAME	TEST MODE		S	O	F	S	B	S	R	D	F	O	N	N	O
		H	P	I	M	U	M	E	A	U	D	M	S	B	C	T
		O	E	R	O	R	E	S	E	E	A	E	L	L	V	H
		R	N	E	K	K	T	L	G	G	O	P	P	P	T	A
		T	T	E	E	E	T	L	O	E	W	.	.	U	G	E
		a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	N
1	MOSFET	Q1		D-G		Y										
2	2SK1722RL			D-S		Y										
3				G-S		Y										
4				D		Y										
5				S		Y										
6				G		Y										
7																
8	CHIP IC	A1		1-2		Y										
9	M51977FP			2-3		Y										
10				3-4		Y										
11				4-5		Y										
12				5-6		Y										
13				6-7		Y										
14				7-8		Y										
15				8-9		Y										
16				9-10		Y										
17				10-11		Y										
18				11-12		Y										
19				12-13		Y										
20				13-14		Y										
21				14-15		Y										
22				15-16		Y										
23				16-17		Y										
24				17-18		Y										
25				18-19		Y										

R *** a : slight b : prolonged

- 11

MODEL : KS15-5		ABNORMAL TESTING		TEST CONDITIONS		TEST RESULTS	
PARTS	NAME	PART NO.		LOAD = 100 %	Vin = 100VAC	Ta = 25°C	
1			19-20	Y			
2			1	Y			Y
3			2	Y			Y
4			3	Y			Y
5			4	Y			Y
6			5	Y			Y
7			6	Y			Y
8			7	Y			Y
9			8	Y			Y
10			9	Y			Y
11			10	Y			Y
12			11	Y			Y
13			12	Y			Y
14			13	Y			Y
15			14	Y			Y
16			15	Y			Y
17			16	Y			Y
18			17	Y			Y
19			18	Y			Y
20			19	Y			Y
21			20	Y			Y
22							
23	CHIP IC	A2	K-A	Y			Y OUTPUT LOW
24	HA17431FPA		K-R	Y			Y OUTPUT LOW
25		R-A	Y				Y

R*** a : slight b : prolonged

TDK-Lambda

TDK-Lambda

MODEL : KS15-5		ABNORMAL TESTING										TEST CONDITIONS		TEST RESULTS		
PARTS	NAME	PART NO.	TEST MODE			LOAD = 100 %			Vin = 100VAC			Ta = 25°C				
1	CHIP IC	A2	S	O	F	S	S	B	S	R	D	F	0	0	N	0
2	HA17431FPA	A	H	P	I	M	M	U	M	E	A	U	:	0	O	C
3		R	O	E	R	O	R	E	D	M	S	B	C	0	O	T
4			R	N	E	K	K	S	L	A	E	L	:	U	H	E
5	CHIP PHOTO COUPLER	PC1	a	b	E	E	E	T	L	H	G	O	P	P	N	G
6	TLP121GR															D
7																
8																
9																
10																
11																
12	CHIP BRIDGE	D1	ONE DIODE	Y									Y	Y	Y	
13	S1ZB60	ONE LEAD	Y										Y	Y	Y	
14																
15	CHIP DIODE	D2	Y													
16	DIFK40		Y													
17																
18	CHIP DIODE	D3	Y													
19	DIFL20U		Y													
20																
21	DIODE	D4	FREEWHEEL	Y									Y	Y	Y	
22	TP802C04		RECTIFIER	Y												
23			FREEWHEEL	Y												
24			RECTIFIER	Y												
25			BOTH	Y												

R*** a : slight b : prolonged

MODEL : KS15-5		ABNORMAL TESTING										TEST CONDITIONS											
PARTS	NAME	TEST MODE					LOAD = 100 %					V _{IN} = 100VAC					TEST RESULTS					NOTE	
		S	O	F	S	R	D	F	O	O	N	C	T	H	H	P	N	E	O				
1	DIODE	D5	FREEWHEEL	Y																			Y
2	TP802C04		RECTIFIER	Y																			Y
3			FREEWHEEL	Y																			Y
4			RECTIFIER	Y																			Y
5			BOTH	Y																			Y
6	CHIP ZENER	ZD1		Y																			Y
7	AW01-07			Y																			Y
8																							Y
9	CAP. FILM	C1		Y																			Y
10	MKC-S683M			Y																			Y
11																							Y
12	CAP. CERAMIC	C2		Y																			Y
13	DE7100F222MVA1N			Y																			Y
14																							Y
15	CAP. CERAMIC	C3		Y																			Y
16	DE7100F222MVA1N			Y																			Y
17																							Y
18	CAP. ELECT	C4		Y																			Y
19	LXA200VB75(M)			Y																			Y
20																							Y
21	CHIP CAP.CERAMIC	C5		Y																			Y
22	C34Y5UH335Z			Y																			Y
23																							Y
24	CHIP CAP.CERAMIC	C6		Y																			Y
25	C2012X7R1H472KT			Y																			Y

*** a : slight b : prolonged

TDK-Lambda

MODEL : KS15-5		ABNORMAL TESTING		TEST CONDITIONS		TEST RESULTS	
PARTS	NAME	PART NO.	TEST MODE	LOAD = 100 %	Vin = 100VAC Ta = 25°C	NOTE	R N
1	CHIP CAP.CERAMIC	C7	Y				Y
2	C2012X7RIH223KT		Y		Y		Y
3							
4	CHIP CAP.CERAMIC	C8	Y		Y		Y
5	GRM40R471J50PT		Y				
6	CHIP CAP.CERAMIC	C9	Y		Y		
7	C2012X7RIE104KT		Y		Y		
8							
9							
10	CHIP CAP.CERAMIC	C10	Y		Y		
11	GR42-2W5R821K500PT		Y				
12							
13	NOT ASSIGNED	C11	Y		Y		
14			Y				
15							
16	CHIP CAP.CERAMIC	C12	Y		Y O/P RIPPLE HIGH.		Y
17	C2012X7RIH223KT		Y				Y
18							
19	CHIP CAP.CERAMIC	C13	Y		Y OUTPUT LOW		Y
20	C2012X7RIE104KT		Y		Y O/P RIPPLE HIGH(STABILITY PROBLEM)		Y
21							
22	CHIP CAP.CERAMIC	C14	Y		Y		Y
23	CM21W5R471K200BT		Y				Y
24							
25							

R *** a : slight b : prolonged

TDK-Lambda

MODEL : KS15-5		ABNORMAL TESTING												TEST CONDITIONS		TEST RESULTS		
PARTS	NAME	TEST MODE			S	O	F	S	S	B	R	D	F	O	N	N	O	R
		PART NO.			H	P	I	M	U	M	E	A	U	C	T	H	E	N
1	CHIP CAP.CERAMIC	C15			O	E	R	O	R	E	D	M	S	B	V	U	A	E
2	CW21W5R681K200BT				R	N	E	K	S	L	A	E	L	.	T	P	N	G
3					T													O
4	CAP . CERAMIC	C16																E
5	CK45-TF2EA472ZYAN																	S
6																		O
7	CHIP CAP.TANTALUM	C17																D
8	F941C226MNC																	
9																		
10	CHIP CAP.TANTALUM	C18																
11	F941C226MNC																	
12																		
13	CHIP CAP.TANTALUM	C19																
14	F941C226MNC																	
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		

*** a : slight b : prolonged

TDK-Lambda

6. 振動試験 VIBRATION TEST

MODEL : KS15-5

(1) 振動試験種類 Vibration test class

掃引振動数耐久試験 Frequency variable endurance test

(2) 使用振動試験装置 Equipment used

新日本測器株製 制御部 F-400-BM-E47

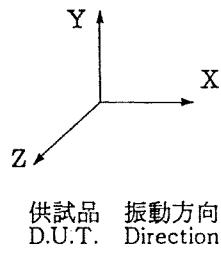
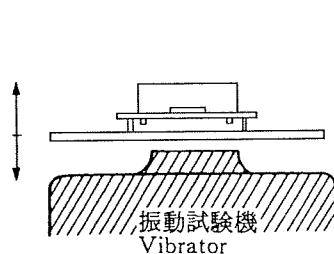
SHIN-NIPPON Controller

SOKKI Co., LTD

加振部 905-FN

Vibrator

(3) 試験方法 Testing method



可変周波数振動試験

- ・周波数範囲 10~55Hz
- ・Sweep frequency
- ・掃引時間 1 分間
- ・Sweep time 1 min.
- ・振幅 一定 (1.65mm)
- ・Amplitude const.
- ・振幅方向 X, Y, Z.
- ・Direction
- ・試験時間 各方向共 1 H
- ・Test time 1H each

(4) 試験結果 Result

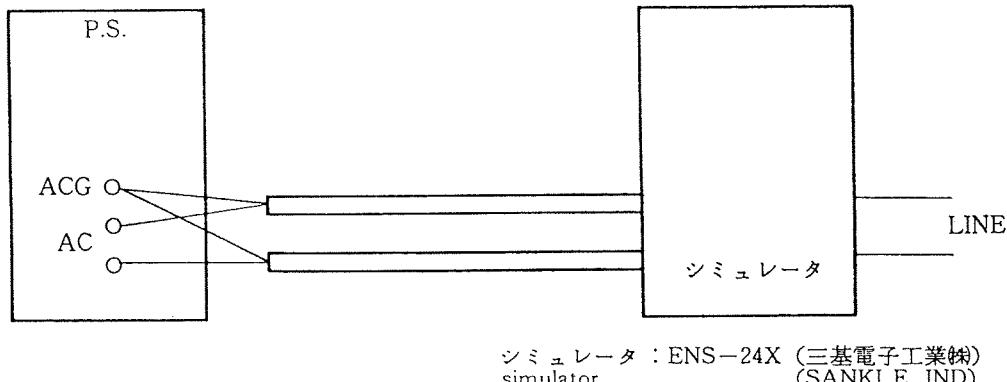
(合格)
OK不合格
NG

測定確認項目 Check item	出力電圧 (V) Vout	リップル (mVp-p) Ripple (mVp-p)	機能・実装状態 D. U. T. state	備考 Note
試験前 Initial 振動方向 Directions	4.987	50	異常なし OK	
X	4.987	48	異常なし OK	
Y	4.983	45	異常なし OK	
Z	4.984	48	異常なし OK	

7. ノイズシミュレート試験 NOISE SIMULATE TEST

MODEL : KS15

(1) 測定回路及び測定機 Test circuit and equipment



(2) 測定条件 Measuring Conditions

- ・入力電圧: 定格
Input voltage Rated
- ・出力電圧: 定格
Output voltage Rated
- ・出力電流: 0%, 100%
Output Current
- ・電源周囲温度: 25°C
Ambient temperature
- ・パルス幅: 50ns~1000ns
Pulse width
- ・ノイズ電圧: 0 ~ 2 kV
Noise level
- ・位相: 0 ~ 360°
Phase shift
- ・極性: +, -
Polarity
- ・MODE : NORMAL, COMMON
- ・TRIG SELECT : LINE

(3) 判定条件 Acceptable conditions

1. 破壊しない事 Not to be broken
2. 出力がダウンしない事 Not to be shut down output
3. その他異常のない事 No other out of orders

(4) 試験結果 Results

合格
 OK

不合格
NG

8. 静電気シミュレーション試験 ELECTRO-STATIC DISCHARGE TEST

MODEL : KS15

(1) 使用計測器 Equipment used

SET-30E (三基電子工業(株))
(SANKI. E. IND.)

放電抵抗: 250Ω 静電容量: 200pF
Discharge resistance Capacity

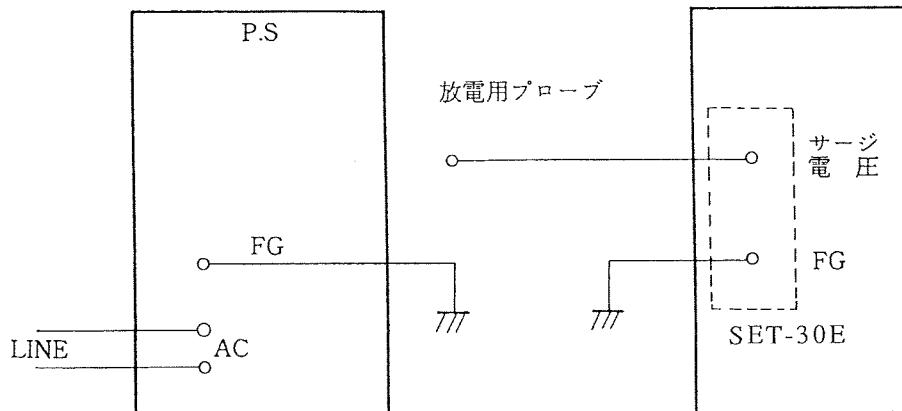
(2) 測定条件 Measuring conditions

- ・入力電圧: 定格 ④ 出力電圧: 定格 ⑤ 出力電流: 定格
- Input voltage : Rated Output voltage : Rated Output current : Rated
- ・電源周囲温度: 25°C ⑥ 印加電圧: $\pm 3\text{KV}, \pm 5\text{KV}, \pm 10\text{KV}, \pm 15\text{KV}$
- Ambient temperature Test voltage

(3) 試験方法 Testing method

被試験電源を稼働状態にしておき、露出部分で人体がふれる可能性のある部分（ケース、入力端子、出力端子、FG端子、ACG端子）に放電をさせ、出力に異常の無い事を確認する。

尚、試験回数は、+，-各3回とし、印加電圧は3KVから15KVまで順次上げていくものとする。Check if there is no abnormal output when the testing voltage is applied to operating D. U. T. (Device Under Test) on its case, input terminal, output terminal, FG terminal and ACG terminal which are exposed parts to human body. Testing cycle is at +, - for three times each, and the applied voltage to be gradually increased from 3KV to 15KV.



(4) 判定条件 Acceptable conditions

1. 破壊しない事 Not to be broken
2. 出力電圧がダウンしない事 Not to be shut down output
3. その他異常の無いこと No other out of orders

(5) 試験結果 Result

合格
OK

不合格
N G

9. 雷サージ試験 IMPULSE TEST

MODEL : KS15

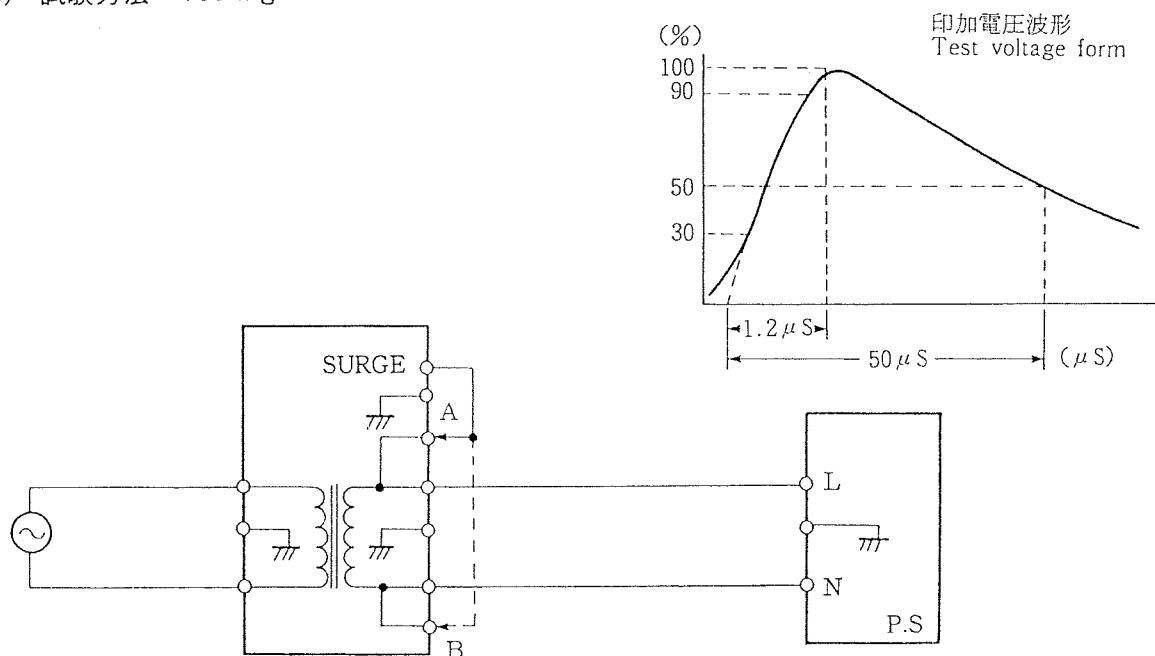
(1) 使用計測器 Equipment used

LSG-12K-E (三基電子工業(株))
(SANKI. E. IND.)

(2) 測定条件 Measuring conditions

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ・入力電圧：定格 | ・印加電圧：5kV |
| Input voltage : Rated | Test voltage |
| ・出力電圧：定格 | ・印加箇所：FG-AC間 |
| Output voltage : Rated | Test point : Between FG-AC |
| ・出力電流：無負荷 | ・試験回数：3回 |
| Output current : No load | Test time : 3 times |
| ・電源周囲温度：25°C | ・極性：+，- |
| Ambient temperature | Polarity |

(3) 試験方法 Testing method



(4) 判定条件 Acceptable conditions

1. 破壊しない事 Not to be broken
2. 出力電圧がダウンしない事 Not to be shut down output
3. その他異常の無いこと No other out of orders

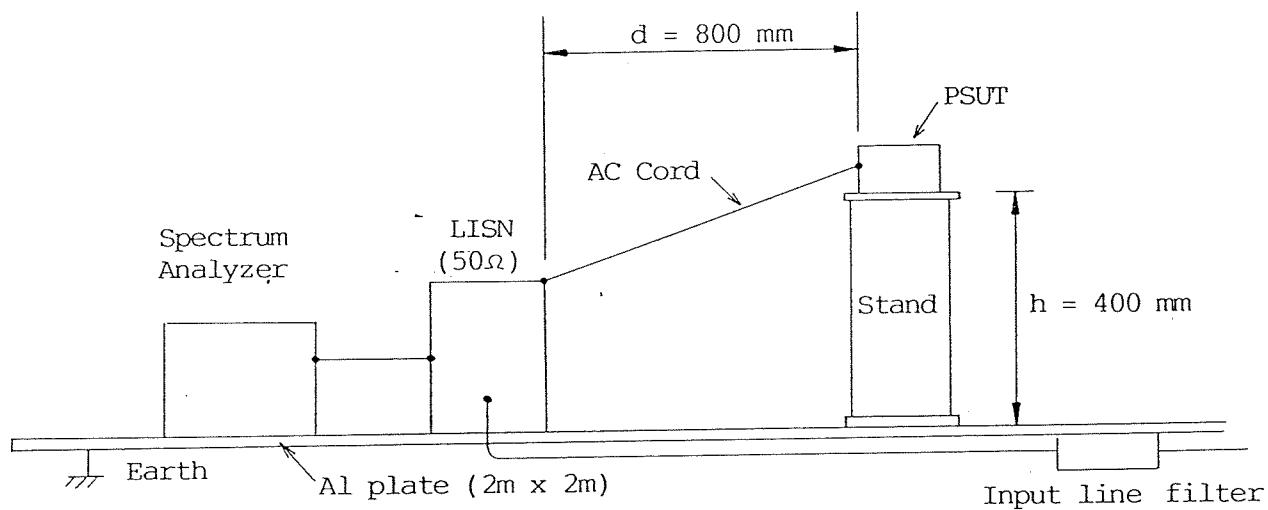
(5) 試験結果 Result

合格
 OK

不合格
N G

E M I T E S T

TEST CIRCUIT :



TEST EQUIPMENTS :

SPECTRUM ANALYZER	8568B	HEWLETT PACKARD
QUASI-PEAK ADAPTER	85650A	HEWLETT PACKARD
RF PRESELECTOR	85685A	HEWLETT PACKARD
LISN	3825/2	EMCO

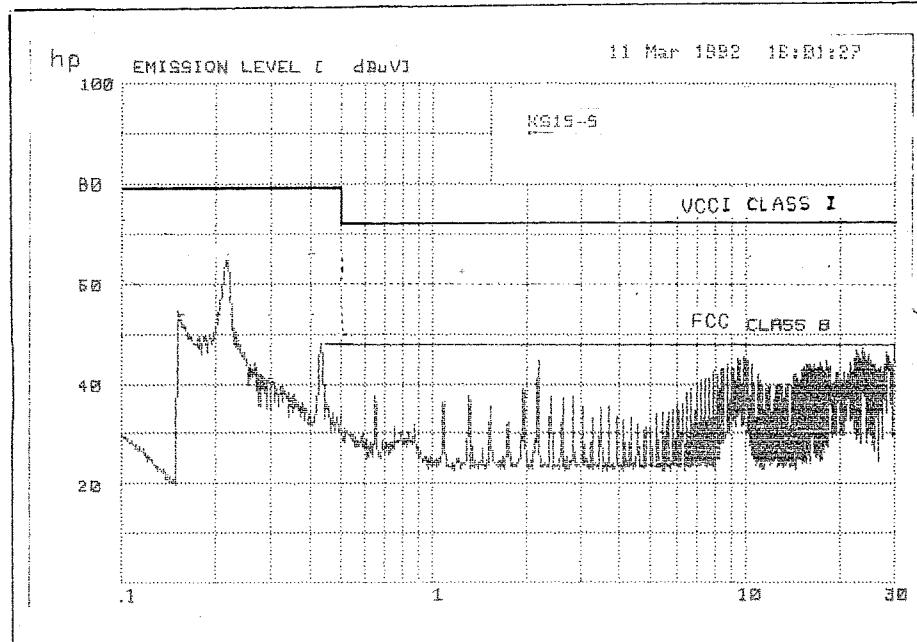
CONDITIONS :

INPUT VOLTAGE	:	AC 100V
OUTPUT VOLTAGE	:	RATED
OUTPUT CURRENT	:	RATED
AMBIENT TEMP.	:	25°C

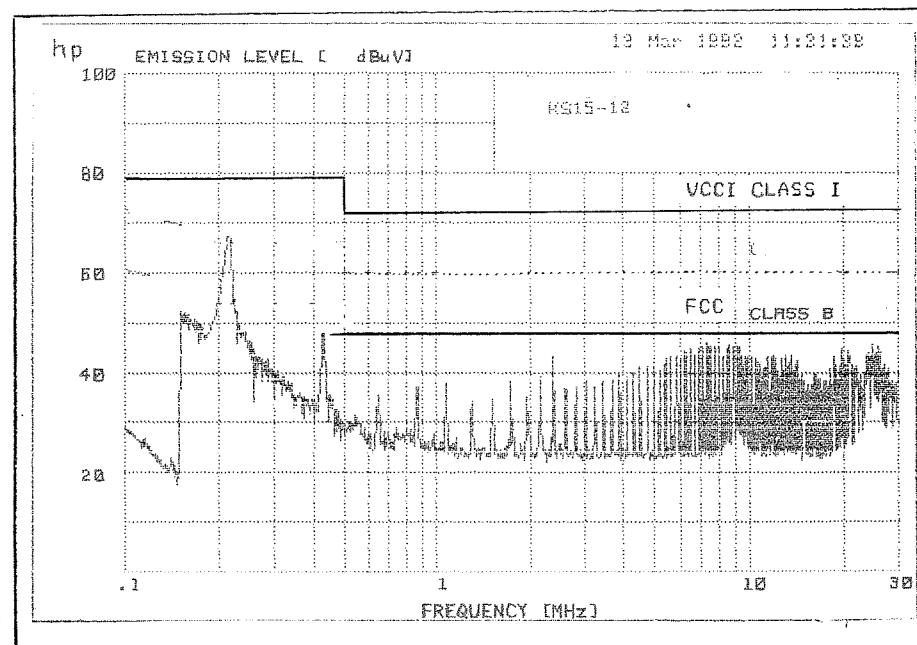
認 APPD	<i>Hatta</i> 8·APR·'92	設 計 ENGR	<i>S. Kuroi</i> 26·MAC·'92	図面番号 D WG - No.
検 図 C H K	<i>Haga</i> 8·APR·'92	製 図 D W G	<i>S. Kuroi</i> 26·MAC·'92	PA759-71-01-

DATE

KS15 - 5



KS15 - 12



認 APPD	.	設 計 ENGR	図面番号 DWG-No.
検 図 C H K	.	製 図 DWG	PA759-71-02-